

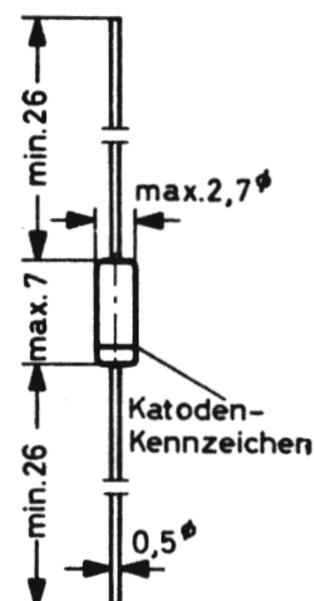
Silizium-Z-Dioden

Arbeitsspannungen gestuft nach der internationalen Reihe E 12 (10%-Reihe)

Glasgehäuse JEDEC DO-7
51A 2 (DIN 41880)

Gewicht ca. 0,2 p
Maße in mm

In listenmäßiger Ausführung werden diese Dioden gegurtet geliefert.
Näheres siehe Seite 54.



Grenzwerte

Arbeitsstrom siehe Tabelle auf der folgenden Seite

Verlustleistung bei $T_U = 25\text{ °C}$ P_{tot} 400*) mW

Sperrschichttemperatur T_j 150 °C

Lagerungstemperaturbereich T_S -55... +150 °C

Kennwerte bei $T_U = 25\text{ °C}$

Durchlaßstrom bei $U_F = 1\text{ V}$ I_F 250 (> 150) mA

Wärmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft R_{thU} < 0,31*) grd/mW

www.datasheetcatalog.com

*) Diese Werte gelten, wenn die Anschlußdrähte in 4 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.

Typ	Arbeits- spannung bei $I_Z = 5 \text{ mA}$	inhär. diff. Widerst. bei $I_Z = 5 \text{ mA}$	Temp.-Koeff. d. Arbeits- spannung bei $I_Z = 5 \text{ mA}$	Sperr- spannung bei $I_R = 1 \mu\text{A}$	zulässiger Arbeitsstrom	
	$U_Z \text{ V}$	$r_{zj} \Omega$	$\alpha_{UZ} 10^{-4}/\text{grad}$	$U_R \text{ V}$	bei $T_U = 45^\circ\text{C}^{**})$ $I_Z \text{ mA}$	bei $T_U = 25^\circ\text{C}^{**})$ $I_Z \text{ mA}$
ZG 1 *)	0,65 ... 0,75	6,5 (< 8)	-26 ... -23	-	260	320
ZG 2,7	2,4 ... 3,1	70 (< 100)	-9 ... -5	-	92	109
ZG 3,3	2,9 ... 3,7	75 (< 100)	-9 ... -4	-	73	86
ZG 3,9	3,5 ... 4,3	75 (< 100)	-7 ... -3	-	63	75
ZG 4,7	4,1 ... 5,2	65 (< 90)	-6 ... 0	-	53	63
ZG 5,6	5,0 ... 6,3	35 (< 75)	-3 ... +4	> 1	46	55
ZG 6,8	6,1 ... 7,5	4 (< 8)	-1 ... +7	> 2	40	47
ZG 8,2	7,3 ... 9,2	4 (< 7)	+2 ... +7	> 3,5	32	38
ZG 10	8,8 ... 11	7 (< 15)	+5 ... +8	> 5	26	31
ZG 12	10,7 ... 13,4	14 (< 30)	+6 ... +9	> 7	21	25
ZG 15	13,0 ... 16,5	20 (< 55)	+7 ... +9	> 10	18	21
ZG 18	16,0 ... 20,0	20 (< 55)	+8 ... +9,5	> 10	14,5	17
ZG 22	19,6 ... 24,4	20 (< 55)	+8 ... +10	> 12	12	14
ZG 27	24,1 ... 30,0	30 (< 100)	+8 ... +10	> 14	9	10,5
ZG 33	29,6 ... 36,5	30 (< 100)	+8 ... +10	> 17	7,3	8,5

Für die Typenreihe ZG 1 ... ZG 33 gelten sinngemäß die Kurven und Kennlinien der Typenreihe ZF 2,7 ... ZF 33.

www.datasheetcatalog.com

*) Die ZG 1 ist eine in Durchlaßrichtung betriebene Silizium-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index „F“ anstatt „Z“ zu setzen. Der durch den Ring gekennzeichnete Anschluß ist mit dem Minuspol zu verbinden.

***) Diese Werte gelten, wenn die Anschlußdrähte in 4 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden.